

طراحی سوئیچ تمام نوری با استفاده از خاصیت غیر خطی Kerr و DIT با نانو کریستال چهار ترازه

حسین خیری فام^۱ کریم عباسیان^۲ کاوه افتخاری^۳

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد- کارشناس ناظر بخش معاونت فنی و مهندسی رایتل - شرکت خدمات ارتباطی رایتل- تهران - ایران

H.Kheiryfam@rightel.ir

۲-دانشیار- دانشکده مهندسی فناوری های نوین، گروه مهندسی فتوپیک- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
K_Abbasian@tabrizu.ac.ir

۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد- دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات- دانشگاه تبریز - تبریز - ایران
K.Eftekhari@gmail.com

چکیده:

در این مقاله یک سوئیچ دو حالته قابل کنترل تمام نوری بهبود یافته ای با استفاده از شفافیت القابی دو قطبی و اثر کر و اندرکنش نقطه کوانتمومی با کاواک الکترودینامیک کوانتمومی پیشنهاد گردیده است. سوئیچ تمام نوری دو حالته قابل کنترل از یک محیط غیرخطی سریع (کریستال های فتوپیکی) و کاواک الکترودینامیک کوانتمومی، کویل شده با دو موج بر نوری، تشکیل شده است. نانو کریستال تزریق شده در فوتونیک کریستال کاواک را سیستم اتمی چهار ترازه در نظر گرفته ایم و سوئیچ نوری پیشنهادی را با روش تمام کوانتمومی طراحی کردایم. به این صورت که هامیلتونین سیستم را نوشتہ و معادلات دینامیکی را می باییم و با محاسبه احتمال انتقال برای دو موج بر عمل سوئیچ زنی نوری را با شبیه سازی در نرم افزار Matlab نمایش می دهیم.

در این مقاله با انتخاب مقادیر مناسب برای پارامترهای اساسی یک سوئیچ تمام نوری بهبود یافته، طراحی شده است. عنوان مثال سرعت سوئیچ زنی با سیستم اتمی چهار ترازه مورد نظر با میدان کنترل اول در حد سه برابر و با میدان کنترل دوم در حد هفت برابر نسبت به دیگر سوئیچ های نوری افزایش یافته است.

کلمات کلیدی: سوئیچ تمام نوری، اثر کر، شفافیت القابی دو قطبی(DIT)، اثر اشتارک

تاریخ ارسال مقاله : ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

تاریخ پذیرش مشروط : ۱۳۹۲/۲/۲۰

تاریخ پذیرش مقاله : ۱۳۹۳/۲/۲۰

نام نویسنده‌ی مسئول: حسین خیری فام

نشانی نویسنده‌ی مسئول: ایران - تهران - خیابان ولیعصر (عج) - خیابان ارمغان غربی - دفتر مرکزی شرکت خدمات ارتباطی رایتل - ۰۹۰۹۲۰۲۲۶.

نیاز روز افزون به انتقال حجم وسیع اطلاعات، باعث توسعه شبکه‌های نوری شده است و طراحی سوئیچ‌های تمام نوری یکی از کلیدی‌ترین بخش ارتباطات در حال حاضر است که ساخت سوئیچ‌های سریع و با مصرف انرژی پایین یکی از اهداف این صنعت می‌باشد.

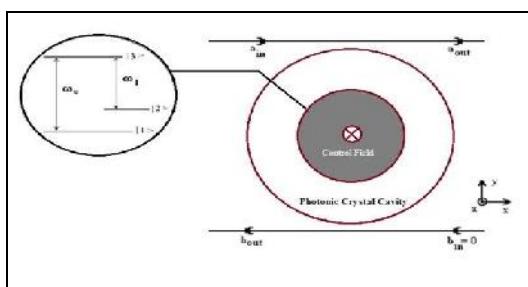
تاکنون سوئیچ‌زنی در این سیستم‌ها به صورت تمام الکترونیکی انجام گرفته است که دارای سرعت‌های متوسط و پایین بوده است. در این سوئیچ‌زنی ابتدا سیگنال‌های نوری به الکتریکی تبدیل می‌شوند و عملیات ذخیره‌سازی و سوئیچ‌زنی به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد و مجددًا بعد از تبدیل به سیگنال نوری در مسیر دیگری انتشار می‌یابد که بسیار زمان بر بوده و با افزایش ظرفیت شبکه این نوع سوئیچ‌زنی جواب‌گوی نیاز شبکه نمی‌باشد که بهترین جایگزین، سوئیچ‌های تمام نوری هستند. مهمترین مزیت سوئیچ‌های تمام نوری آن است که مسیردهی سیگنال‌های نوری بدون تبدیل به سیگنال‌های الکتریکی انجام می‌پذیرد. بنابراین مستقل از سرعت و پروتکل داده هستند. سوئیچ‌زنی نوری باعث کاهش تجهیزات شبکه و افزایش سرعت و در نتیجه افزایش ظرفیت و کاهش توان مصرفی شبکه می‌شود. همچنین حذف تبدیلات E/O, O/E هزینه‌های سامانه را کاهش می‌دهد.

توسعه عرصه مهندسی فوتونیک و سیستم‌های تمام نوری که نویدبخش تحقق شبکه‌های تمام نوری می‌باشد، ما را بر آن داشته که در این حوزه، سوئیچ تمام نوری کوانتمومی بهبود یافته ای معرفی نماییم. سوئیچ تمام نوری با سرعت بالا و مصرف توان پایین نقش مهمی در شبکه‌های نوری آینده خواهند داشت. اخیراً تحقیقات زیادی برای طراحی ادوات تمام نوری جهت پردازش نوری صورت گرفته و به ویژه سعی شده است، از خواص غیر خطی نور مانند EIT^۳ استفاده شود. اما به دلیل مشکل عدم تطابق سرعت گروه در EIT یکی از بهترین جایگزین‌ها شفافیت القائی دو قطبی (DIT^۴) و به کارگیری کاواک الکترودینامیک کوانتمومی می‌باشد. در حوزه‌های محاسبات کوانتمومی، پردازش اطلاعات کوانتمومی، سوئیچ‌زنی کوانتمومی و طراحی عملی قطعات نوری از خواص غیرخطی نور استفاده زیادی می‌شود. لذا در دهه‌های اخیر تحقیقات و افری برازاس خاصیت غیرخطی صورت گرفته و تا تحقق عملی آن کارهای زیادی باید انجام گیرد که یکی از متبادل ترین خواص غیرخطی، اثر کر بوده که نتیجه اثر XPM^۵ و جذب دو فوتونی است [۲ و ۳]. مشکل اصلی در

حصول این کاربردها ضعیف بودن خاصیت غیرخطی در مقایسه با خاصیت خطی مواد متبادل است. خوشبختانه خاصیت غیرخطی مواد در کاربردهایی مانند پردازش اطلاعات کوانتمومی و سوئیچ زنی براساس شفافیت القائی دوقطبی با چند فوتون و بعضًا با تک فوتون حاصل می‌شود. اثر غیرخطی کر با تعداد محدود فوتون در سیستم اتمی گازی با استفاده از شفافیت القائی الکترومغناطیسی مشاهده شده و ایده اصلی توسط اسمیت و امام اوغلی ارائه شده است [۵ و ۴]. بررسی‌های اسمیت و امام اوغلو روی سیستم اتمی چهار ترازه نوع N امکان تقویت خواص غیرخطی مانند مدولاسیون فاز دو میدان نوری را در رژیم EIT ایجاد کرد. البته بعداً سوئیچ کوانتمومی با سیستم اتمی چهار ترازه نوع N طراحی شد که دو فوتون را جذب می‌کرد. در این سیستم افزودن تراز اتمی چهارمی به سیستم سه ترازه اندرکنش غیرخطی بین میدان پرور ایجاد می‌کرد و فوتون‌های یک میدان نوری فوتون‌های میدان دیگر را تحت تاثیر قرار می‌داند. خواص غیرخطی نور با محبوس شدن فوتون در داخل کاواک تقویت می‌شود و با تزریق نقطه کوانتمومی^۶ دو ترازه در داخل کاواک می‌توان مسیر انتشار میدان نوری را از یک موج بر به موج بر دیگر سوئیچ کرد. در این حالت شفافیت به دلیل تداخل مخرب میدان کاواک است که از ورود میدان به داخل کاواک جلوگیری می‌کند.

۲ - تئوری و روابط مورد استفاده

در این مقاله، ما یک سوئیچ قابل کنترل تمام نوری بهبود یافته ای را پیشنهاد نموده‌ایم که طرح کلی آن در شکل (۱) نشان داده شده است. دو موجبر a و b با کاواک کریستالی فوتونیک دو بعدی که در نانوکریستال‌های (نقاط کوانتمومی) ^۳ و ^۴ ترازه کوپل شده‌اند، جفت می‌شوند.



شکل (۱): سیستم سوئیچ کاواک - موجبر پیشنهادی، شامل طرح کلی نانوکریستال‌های سه ترازه نوع Δ کوپل شده در کاواک PC

که Ω_P ، Ω_C ، d_{13} و d_{23} به ترتیب فرکانس‌های رابی سیگنال و میدان‌های کنترل، ممان دوقطبی انتقال $\langle 3 | - \rangle_1$ ، ممان دو قطبی $\langle 3 | - \rangle_2$ و عدم تنظیم میدان با فرکانس تشدید می‌باشد.

حال می‌توان دید که چطور کاواک PC از یک ماده غیر شفاف به ماده شفاف تغییر می‌یابد که نتیجه‌ای از تغییر حالت‌های نانوکریستالی با بکاربردن یک میدان کنترل قوی است. در نتیجه پس از جابجایی دادن سیگنال پروب مشدد با انرژی مابین حالت‌های اتمی پایه^۱ و برانگیخته، میدان ورودی از موج بر اصلی به موج بر دیگری از طریق کاواک انتقال می‌یابد و فرآیند سوئیچینگ کامل می‌شود. هامیلتونین سیستم سه ترازه را با استفاده از تقریبات موج چرخشی می‌توان به صورت زیر نوشت

[۱]:

$$\begin{aligned} H = & \hbar \left((\omega_{13} - i \frac{\Gamma}{2}) |3\rangle\langle 3| + (\hbar\omega_{12}) |2\rangle\langle 2| + \right. \\ & \hbar(\omega_0 - i \frac{\kappa}{2}) C^+ C + i g \hbar (C^+ \sigma_-^{13} + \sigma_+^{13} C) + \\ & \hbar \Omega_1 (\sigma_+^{23} e^{-i\omega_1 t} + \sigma_-^{23} e^{i\omega_1 t}) + \frac{\omega_a}{\omega_a} \hbar a^+ (\omega) a(\omega) d\omega + : (V) \\ & \left. \int_{-\omega_b}^{\omega_b} \hbar \omega b^+ (\omega) b(\omega) d\omega + i \hbar \sqrt{\frac{\gamma}{2\pi - \omega_a}} (a^+(\omega) C - C^+ a(\omega)) d\omega + \right. \\ & \left. i \hbar \sqrt{\frac{\omega_b}{2\pi - \omega_b}} (b^+(\omega) C - C^+ b(\omega)) d\omega \right] \end{aligned}$$

C عملگرهای جابجاکننده دو قطبی، σ_+^{23} و σ_-^{23} و σ_-^{13} ، σ_+^{13} کننده کاواک، به ترتیب عملگرهای محوکننده و خلق^۲ و C^+ و C نرخ کاهش انرژی کاواک $\omega_0 / Q = k = \omega_0 / \omega$ فرکانس کاواک است، فاکتور کیفیت کاواک است. Q (بدون جفت شدن با کاواک) و بر با پهنهای به اپراتورهای میدان برای مدِ دو موج (ω) و (ω') نمایند: باند مشخص اشاره دارند که روابط تبدیل زیر را ارضا می‌کنند:

$$\begin{aligned} [\hat{a}^+(\omega), \hat{a}(\omega')] &= \delta(\omega - \omega') \\ [\hat{b}^+(\omega), \hat{b}(\omega')] &= \delta(\omega - \omega') \end{aligned} \quad (8)$$

در هامیلتونین، جمله‌ی اول انرژی تراز تحریک سوم، جمله‌ی دوم بیانگر انرژی تراز نسبتاً پایدار دوم با طول عمر زیاد است. انرژی تراز پایه، صفر فرض شده است. جمله سوم انرژی مدد کاواک بوده و در جمله چهارم گذار $\langle 3 | - \rangle_1$ دو قطبی با ضرب کوپلینگ g در حالت تشدید به کاواک کوپل شده است. در جمله پنجم میدان کنترلی به صورت غیر تشدید گذار $\langle 3 | - \rangle_2$ دو قطبی را با فرکانس ω_1 و فرکانس رابی Q تحریک می‌کند.

در این ساختار سیگنال ورودی در موج بر a منتشر می‌شود و میدان کنترل در جهت عمودی به کاواک PC^۳ اعمال می‌شود. در غیاب میدان کنترل، موج برها شفاف هستند و کاواک PC غیر شفاف می‌باشد، بنابراین میدان سیگنال ورودی در موج بر a منتشر می‌شود. در حالیکه در حضور میدان کنترل، کاواک نسبت به میدان سیگنال ورودی شفاف می‌شود، میدان سیگنال ورودی به موج بر b از طریق کاواک PC، سوئیچ می‌شود. برای نشان دادن این فرآیند، یک سیستم اتمی سه ترازه در نظر می‌گیریم که با استفاده از ساختار مناسب نقاط کوانتومی می‌توانند تحقق یابند. در غیاب میدان کنترل، حالت نانوکریستالی می‌تواند با استفاده از حالت‌های ساده ترازهای $\langle 1 |$ ، $\langle 2 |$ و $\langle 3 |$ تشریح شوند. پس از بکارگرفتن میدان کنترل حالت‌های نانوکریستالی به حالت‌های پوشیده نموده می‌یابند که با استفاده از ترازهای $|a^+\rangle$ ، $|a^0\rangle$ و $|a^-\rangle$ قابل توصیف می‌باشند. حالت‌های پوشیده با استفاده از

منابع [۶-۱۱] به ازای حالت‌های اتمی محض بدست می‌آیند:

$$\begin{aligned} |a^+\rangle &= \sin \theta \sin \varphi |1\rangle + \cos \varphi |3\rangle + \cos \theta \sin \varphi |2\rangle \\ |a^0\rangle &= \cos \theta |1\rangle - \sin \theta |2\rangle \\ |a^-\rangle &= \sin \theta \cos \varphi |1\rangle - \sin \varphi |3\rangle + \cos \theta \cos \varphi |2\rangle \end{aligned} \quad (1)$$

حالات تاریک و دو حالات $|a^+\rangle$ و $|a^-\rangle$ جابجایی‌های بالا و پایین به ترتیب با انرژی‌های $\hbar\omega^+$ و $\hbar\omega^-$ می‌باشند که به صورت زیر است [۶-۱۱]:

$$\hbar\omega^\pm = \frac{\hbar}{2} \left(\Delta \pm \sqrt{\Delta^2 + \Omega_P^2 + \Omega_C^2} \right) \quad (2)$$

زوازای θ و ϕ با روابط زیر تعریف می‌شوند:

$$\tan \theta = \frac{\Omega_P}{\Omega_C} \quad (3)$$

$$\tan 2\phi = \frac{\sqrt{\Omega_P^2 + \Omega_C^2}}{\Delta} \quad (4)$$

فرکانس نوسان رابی جمعیت الکترونی بین دو حالت‌های نانوکریستالی با رابطه زیر معرفی می‌شوند:

$$\Omega_P = \frac{d_{13} E_P}{\hbar} \quad (5)$$

$$\Omega_C = \frac{d_{23} E}{\hbar} \quad (6)$$

که عدم تنظیم‌های مددکاری، فرکانس‌های پریوپ و میدان کنترل از فرکانس‌های رزونانس متناظر، به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\delta_0 = \omega_c - \omega_0 \quad (15)$$

$$\delta_{13} = \omega - \omega_{13} \quad (16)$$

$$\delta_{23} = \omega - \omega_{23} \quad (17)$$

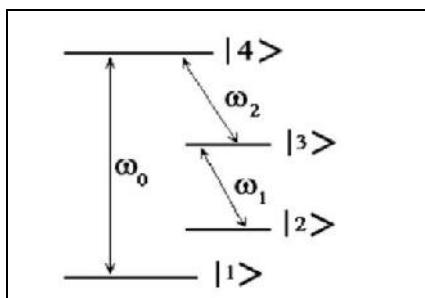
حال می‌توان ضرایب انتقال موج‌برها را با معادلات زیر محاسبه نمود:

$$T_a = \frac{\langle a_{out}^\dagger a_{out} \rangle}{\langle a_{in}^\dagger a_{in} \rangle} \quad (18)$$

$$T_b = \frac{\langle b_{out}^\dagger b_{out} \rangle}{\langle a_{in}^\dagger a_{in} \rangle} \quad (19)$$

با توجه به روابط ذکر شده برای سیستم اتمی سه ترازه، برای سیستم اتمی چهارترازه که در شکل (۲) نشان داده شده است، هامیلتونین بصورت معادله (۲۰) نوشته می‌شود:

$$H = \hbar [(\omega_{12} |2\rangle\langle 2| + \omega_{13} |3\rangle\langle 3| + \omega_{14} (|4\rangle\langle 4| - i\frac{\Gamma}{2}) + (\omega_0 - i\frac{\kappa}{2}) C C + g(C \sigma_-^{14} + C \sigma_+^{14}) + \Omega_1 (\sigma_+^{23} e^{-i\omega_1 t} + \sigma_-^{23} e^{i\omega_1 t}) + \Omega_2 (\sigma_+^{34} e^{-i\omega_2 t} + \sigma_-^{34} e^{i\omega_2 t}) + \frac{\omega_a}{-\omega_a} \int \omega a(\omega) a(\omega) d\omega + \frac{\omega_b}{-\omega_b} \int \omega b(\omega) b(\omega) d\omega + i \sqrt{\frac{\gamma}{2\pi}} \frac{\omega_a}{-\omega_a} \int (a(\omega) C + a(\omega) C) d\omega + i \sqrt{\frac{\gamma}{2\pi}} \frac{\omega_b}{-\omega_b} \int (b(\omega) C + b(\omega) C) d\omega]$$



شکل (۲): طرح کلی نانوکریستال‌های ۴ ترازه کوپل شده در کاواک

که مشابه با سیستم اتمی سه ترازه، عبارت اول، انرژی تراز دوم و عبارت دوم، انرژی تراز سوم و عبارت سوم، انرژی تراز چهارم با نرخ میرایی آنی Γ و انرژی تراز اول صفر در نظر گرفته

جمله‌های ششم و هفتم انرژی مدهای دو موج‌بر با پهنهای باند محدود را نشان می‌دهند و جملات هشتم و نهم انتقال انرژی بین کاواک و موج‌بر بالایی و پایینی را نشان می‌دهند.

نرخ میرایی تشعشع سیستم که ناشی از برخورد سیستم با میدان‌های خارجی می‌باشد و با شدت جفت سازی و تراکم مد میدان‌های خارجی متناسب می‌باشند. بنابراین سرعت نقصان تشعشع از کاواک موج‌بر بصورت γ ثابت در نظر گرفته می‌شود. دو موج‌بر همسان می‌باشند بنابراین ω را به عنوان فرکانس مرکزی برای هر دو آنها در نظر می‌گیریم.

بر پایه هامیلتونین مفروض، دینامیک‌های اپراتورهای \hat{C} و σ_-^{23} با استفاده از معادلات هایزنبرگ بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{aligned} \frac{dC}{dt} &= -(i\omega_0 + \gamma + \frac{\kappa}{2}) C - \sqrt{\gamma} (a_{in} + b_{in}) - ig \sigma_-^{13} \\ \frac{d\sigma_-^{13}}{dt} &= -(i\omega_{13} + \frac{\Gamma}{2}) \sigma_-^{13} + ig \sigma_z^{13} C - i\Omega \sigma_-^{13} \sigma_+^{23} e^{-i\omega_1 t} \\ \frac{d\sigma_-^{23}}{dt} &= -(i\omega_{23} + \frac{\Gamma}{2}) \sigma_-^{23} - ig \sigma_-^{23} \sigma_+^{13} C - i\Omega \sigma_-^{13} \sigma_+^{23} e^{-i\omega_1 t} \end{aligned} \quad (9)$$

که میدان ورودی \hat{a}_{in} و \hat{b}_{in} به میدان خروجی \hat{a}_{out} و \hat{b}_{out} به صورت مرتبط هستند:

$$a_{out} = a_{in} \sqrt{\gamma} C \quad (10)$$

$$b_{out} = b_{in} \sqrt{\gamma} C \quad (11)$$

با استفاده از تبدیل فوریه با برخی تقریبات و محاسبات ریاضی، معادلات (۱۰) و (۱۱) برای حالت خروجی موج‌بر بدست می‌آیند. فرض نموده‌ایم که سیگنال نوری برای انتقال الکترون‌ها از مد پایه به مد بالایی بسیار ضعیف می‌باشد و میدان کنترل به اندازه کافی از تشدید دور است. بنابراین انتقال جمعیت توسط

میدان کنترل نادیده گرفته می‌شود:[۱۲]

$$a_{out} = \frac{-\gamma b_{in} + (i\delta_0 + \kappa/2 - \frac{g^2}{-i\delta_{13} + \Gamma/2 - S}) a_{in}}{(-i\delta_0 + \gamma + \kappa/2 - \frac{g^2}{-i\delta_{13} + \Gamma/2 - S})} \quad (12)$$

$$b_{out} = \frac{-\gamma a_{in} + (i\delta_0 + \kappa/2 - \frac{g^2}{-i\delta_{13} + \Gamma/2 - S}) b_{in}}{(-i\delta_0 + \gamma + \kappa/2 - \frac{g^2}{-i\delta_{13} + \Gamma/2 - S})} \quad (13)$$

که $S(\delta_{23}, \Omega, \Gamma)$ با معادله (۱۴)، تنها وابستگی میدان خروجی به میدان کنترل است که به عنوان جابجایی اشتارک شناخته می‌شود:

$$S = \frac{\Omega^2}{-i\delta_{23} + \Gamma/2} \quad (14)$$

عدم تنظیم‌ها مد کاواک، فرکانس‌های میدان کنترل و پروب از فرکانس‌های تشدید متناظر بصورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\delta_{14} = \omega - \omega_{14} \quad (27)$$

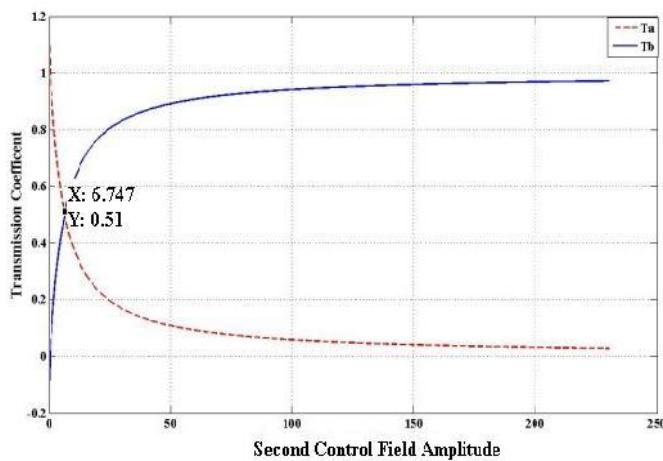
$$\delta_{14} = \omega - \omega_{14} \quad (28)$$

$$\delta_{34} = \omega_2 - \omega_{34} \quad (29)$$

$$\delta_{23} = \omega_1 - \omega_{23} \quad (30)$$

۳- شبیه‌سازی

در شکل (۳) ضریب انتقال سوئیچ با حضور نانو کریستال چهار ترازه در داخل کاواک در مقایسه با دامنه میدان کنترلی دوم رسم شده است (با فرض ثابت بودن $\Omega_1 = 1\text{ GHz}$).



شکل (۳): ضریب انتقال سوئیچ با حضور نانو کریستال چهار ترازه در داخل کاواک در مقایسه با دامنه میدان کنترلی دوم

می‌توان دید که در $S.C.F.A. = 0^9$ میدان ورودی در فیبر نوری اصلی می‌ماند یا بعبارتی بطور مستقیم و بدون کوپل شدن به کاواک از فیبر بالائی عبور می‌کند $T_a \approx 1$. با افزایش دامنه میدان کنترلی دوم، میدان ورودی به کاواک کوپل می‌شود و در نتیجه T_a بطور پیوسته کاهش و T_b بطور پیوسته افزایش می‌یابد. وقتی که $S.C.F.A. = 6,75$ میدان ورودی به هر دو خروجی می‌رسد $T_a = T_b = 0.5$. با افزایش فرکانس رابی $T_a = 100$ ، ضریب انتقال $T_b = 0.988$ و ضریب انتقال $T_a \approx 0.012$ می‌رسد و عمل سوئیچ‌زنی انجام می‌گیرد. در نتیجه سوئیچ تمام نوری کنترل شده بوسیله دو کنترلی با فرکانس رابی پائین تر طراحی کیم و سرعت سوئیچ‌زنی با میدان کنترل دوم در حد هفت برابر نسبت به دیگر سوئیچ‌های نوری [13] افزایش یافته است. بدین صورت که مدت زمان عمل سویچینگ (گذار از

شده است و عبارت چهارم، انرژی مد کاواک و عبارت پنجم، انتقال دوقطبی از تراز ۱ به تراز ۴ که با قدرت کوپلینگ g به کاواک کوپل می‌شود. عبارت ششم، میدان کنترلی دوقطبی را با فرکانس Ω_1 و فرکانس نوسان رابی Ω_1 درایو می‌کند. عبارت هفتم، میدان کنترلی دوقطبی را بطرف کاواک با فرکانس Ω_2 و فرکانس نوسان رابی Ω_2 درایو می‌کند. عبارت هشتم و نهم، انرژی مدهای دو فیبرهای نوری با پهنهای باند محدود نشان می‌دهد و عبارت دهم و یازدهم، انرژی کوپل شده کاواک با فیبرهای که قدرت کوپلینگ مابین کاواک و فیبرها ثابت در گرفته شده است. برپایه هامیلتونین نشان داده شده، معادلات هایزنبیگ بصورت روابط (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) داده می‌شود:

$$\frac{d\sigma_{-}^{14}}{dt} = -(i\omega_{14} + \frac{\Gamma}{2})\sigma_{-}^{14} + ig\sigma_z^{14}C - i\Omega_2\sigma_{-}^{13}\sigma_{+}^{14} \quad (21)$$

$$\frac{d\sigma_{-}^{23}}{dt} = -(i\omega_{23} + \frac{\Gamma}{2})\sigma_{-}^{23} - i\Omega_1\sigma_z^{23}e^{-i\omega_1 t} + i\Omega_2(\sigma_{-}^{23}\sigma_{-}^{34})e^{-i\omega_2 t} \quad (22)$$

$$\frac{d\sigma_{-}^{34}}{dt} = -(i\omega_{34} + \frac{\Gamma}{2})\sigma_{-}^{34} - ig\sigma_{-}^{34}\sigma_{+}^{14}C - i\Omega_1\sigma_{-}^{23}\sigma_{-}^{34}e^{-i\omega_1 t} - i\Omega_2\sigma_z^{34}e^{-i\omega_2 t} \quad (23)$$

میدان‌های ورودی و خروجی به مد کاواک با معادلات (۱۰) و (۱۱) مرتبط می‌شوند. برای کاواک PC کوپل شده به نانوکریستال ۴ ترازه خروجی‌های موج بر با معادلات (۲۴) و (۲۵) زیر بددست می‌آیند:

$$a_{out} = \frac{-\gamma b_{in} + (-i\delta_0 + \kappa/2 + \frac{g^2}{-i\delta_{14} + \Gamma/2 + SS})a_{in}}{(-i\delta_0 + \gamma + \kappa/2 + \frac{g^2}{-i\delta_{14} + \Gamma/2 + SS})} \quad (24)$$

$$b_{out} = \frac{-\gamma a_{in} + (-i\delta_0 + \kappa/2 + \frac{g^2}{-i\delta_{14} + \Gamma/2 + SS})b_{in}}{(-i\delta_0 + \gamma + \kappa/2 + \frac{g^2}{-i\delta_{14} + \Gamma/2 + SS})} \quad (25)$$

که تنها وابستگی میدان خروجی به میدان کنترل توسط $SS (\delta_{34}, \delta_{23}, \Omega_1, \Omega_2, \Gamma)$ با رابطه (۲۶) داده شده است:

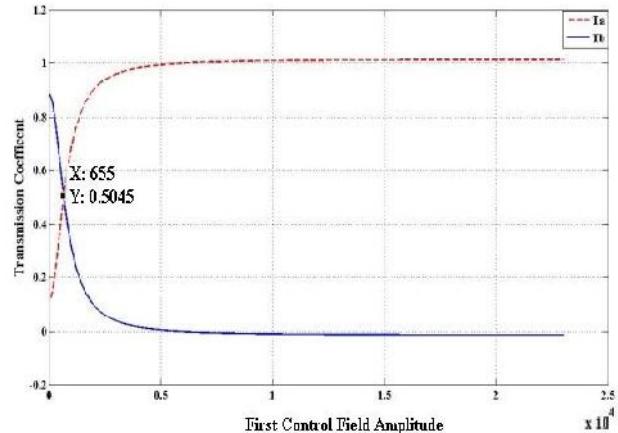
$$SS = \frac{\Omega_2^2}{i\delta_{34} + \Gamma/2 - \frac{\Omega_1^2}{i\delta_{23} + \Gamma/2}} \quad (26)$$

را مورد بررسی قرار دادیم. ضرایب انتقال سوئیچ پیشنهادی برای نانوکریستال‌های چهار ترازه تزریق شده در سیستم موج‌بر-کاواک PC در مقابل میدان کنترل اول و دوم نشان داده شده‌اند. می‌توان دید با انتخاب مقادیر مناسب برای پارامترهای اساسی یک سوئیچ تمام نوری بهبود یافته، طراحی شده است. علی‌رغم فرکانس رابی کمتر و متعاقباً دامنه میدان کنترلی پایین‌تر و مصرف توان کمتر، سرعت سوئیچ‌زنی با سیستم اتمی چهار ترازه مورد نظر با میدان کنترل اول در حد سه برابر و با میدان کنترل دوم در حد هفت برابر نسبت به دیگر سوئیچ‌های نوری افزایش یافته است.

مراجع

- [1] M.O. Scully, M.S. Zubairy, Quantum Optics, Cambridge University Press, 1997.
- [2] G. S. Agarwal, K. T. Kapale, "Subwavelength atom localization via coherent population trapping", *opt. Phy.* 39, 3437-3446, 2006.
- [3] Jelena Vuckovic and Yoshihisa Yamamoto "Photonic crystal microcavities for cavity quantum electrodynamics with a single quantum dot", *APP. Phy. Letters*, 82, 15, 2003.
- [4] J. Vuckovic, M. Loncar, H. Mabuchi, and A. Schere, "Design of photonic crystal microcavities for cavity QED", *Physical Review*, 65, 016608, 2002.
- [5] J. A. Sauer, K. M. Fortier, M. S. Chang, C. D. Hamely, and M. S. Chapman "cavity QED with optically transported atoms", *Phys. Rev A* 69, 51804, 2004.
- [6] A. Rostami, K. Abbasian, All-optical filter design: electromagnetically induced transparency and ring resonator, in: Proceedings of the 2007 IEEE International Conference on Telecommunications and Malaysia International Conference on Communications, 14–17 May 2007, Penang, Malaysia.
- [7] R. Yadipour, K. Abbasian, A. Rostami, Z.D. KoozehKanani, Progress in Electromagnetics Research, PIER 77 (2007) 149.
- [8] Yune Hyoun Kim, Nam Su Kim, Youngjoo Chung, Un-Chul Paek, Won-Taek Han, *Optics Express* 12 (4) (2004) 652.
- [9] K. Abbasian, A. Rostami, Z.D. KoozehKanani, Progress in Electromagnetics Research 5 (2008) 25.
- [10] H. Habibiyan, H. Ghafoori-Fard, K. Abbasian, A. Rostami, Ultrasmall and tunable all-optical photonic crystal based demultiplexer for DWDM systems, *Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications*, in press.
- [11] A. Rostami, K. Abbasian, P.S. Khodashenas, F. Janabi-Sharifi, *Proceedings of SPIE* 7266 (2008) 726613.

$T \approx 0.9$ به یک هفتم رسیده و با افزایش شب منحنی در مرحله سویچینگ همراه بوده است. در شکل (4) ضریب انتقال سوئیچ با حضور نانوکریستال چهار ترازه در داخل کاواک در مقایسه با دامنه میدان کنترلی اول رسم شده است (با فرض ثابت بودن $\Omega_2 = 1 \text{ GHz}$).



شکل (4): ضریب انتقال سوئیچ با حضور نانوکریستال چهار ترازه در داخل کاواک در مقایسه با میدان کنترلی اول

می‌توان دید که در $F.C.F.A. = 0$ میدان ورودی در فiber نوری پائینی می‌ماند یا عبارتی بطور مستقیم و با کوپل شدن به کاواک از فiber پائینی عبور می‌کند $T_b \approx 0.9$. با افزایش فرکانس رابی 1Ω و دامنه میدان کنترلی اول، میدان ورودی از کاواک جدا شده و در نتیجه T_a بطور پیوسته افزایش و T_b بطور پیوسته کاهش می‌باید. وقتی که دامنه میدان کنترلی اول به مقدار $F.C.F.A. = 655$ میدان ورودی به هر دو خروجی می‌رسد و $T_a = T_b = 0.5$. با افزایش میدان کنترلی به مقدار $T_a = 350$ و $T_b = 0.988$ ، ضریب انتقال $F.C.F.A. \approx 0.012$ می‌رسد و عمل سوئیچ‌زنی بصورت معکوس انجام می‌گیرد. در نتیجه توانستیم سوئیچ تمام نوری کنترل شده بوسیله دو کنترلی با فرکانس رابی پائین تر طراحی کنیم. علی‌رغم فرکانس رابی کمتر و توان پایین‌تر، سرعت سوئیچ‌زنی با میدان کنترل دوم در حد سه برابر نسبت به دیگر سوئیچ‌های نوری [۱۳] افزایش یافته است. بدین صورت که مدت زمان عمل سوئیچینگ به یک سوم رسیده و با افزایش شب منحنی در مرحله سویچینگ همراه بوده است.

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله سوئیچ نوری تمام کوانتومی با استفاده از ساختار Λ و سیستم اتمی سه ترازه و چهار ترازه‌ی بهبود یافته‌ای

- [12] Wen-Xi Lai, Hong-Cai Li, Rong-Can Yang, Optics Communications 281 (2008).
- [13] K. Eftekhari, K. Abbasian, A. Rostami, Opt. Commun., doi:10.1016/j.optcom.2009.12.064, 2009.

زیرنویس‌ها

- ¹ Optical to Electrical Conversion
² Electrical to Optical Conversion
³ Electromagnetically Induced Transparency
⁴ Dipole Induced Transparency
⁵ Cross-Phase Modulation
⁶ Quantum Dot
⁷ Photonic Crystal
⁸ Ground Atomic
⁹ Second Control Field Amplitude
¹⁰ First Control Field Amplitude



